



	<p>Hersteller-Teilenummer: SIJA58DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SIJA58DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIJA58DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.65 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	27.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIJA58DP-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3750pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 60A (Tc) 27.7W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIJA58DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIJA58DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIJA58DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIJA58DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIJH440E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8</p>	 <p>SIJA54DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJA54DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJA52DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>
 <p>SIJA52DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJ900DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p>SIJA72ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJ800DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIJA58DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIJA58DP-T1-GE3 Datenblatt Vishay	SIJA58DP-T1-GE3-Komponenten	SIJA58DP-T1-GE3-Datenblätter	SIJA58DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIJA58DP-T1-GE3
SIJA58DP-T1-GE3 Electronic	SIJA58DP-T1-GE3 Hersteller	SIJA58DP-T1-GE3 Verteiler	SIJA58DP-T1-GE3 Bild	SIJA58DP-T1-GE3 Teil
SIJA58DP-T1-GE3 Preis	SIJA58DP-T1-GE3 Original	SIJA58DP-T1-GE3 garantiert	SIJA58DP-T1-GE3 RFQ	SIJA58DP-T1-GE3 Inventar
SIJA58DP-T1-GE3 Neu				SIJA58DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited